

# めっき試料の脱ガス評価

## Ni/Auめっきの昇温脱離ガス分析(TDS)

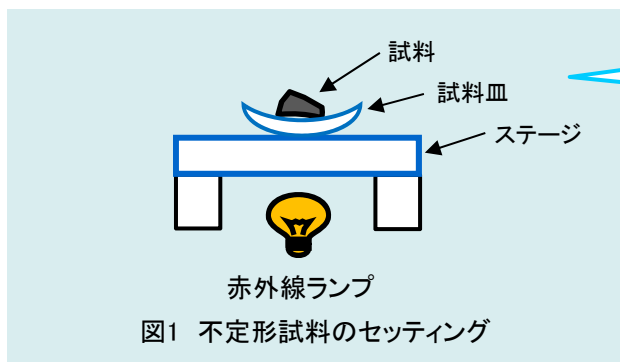
測定法 : TDS  
 製品分野 : LSI・メモリ  
 分析目的 : 組成評価・同定・微量濃度評価

### 概要

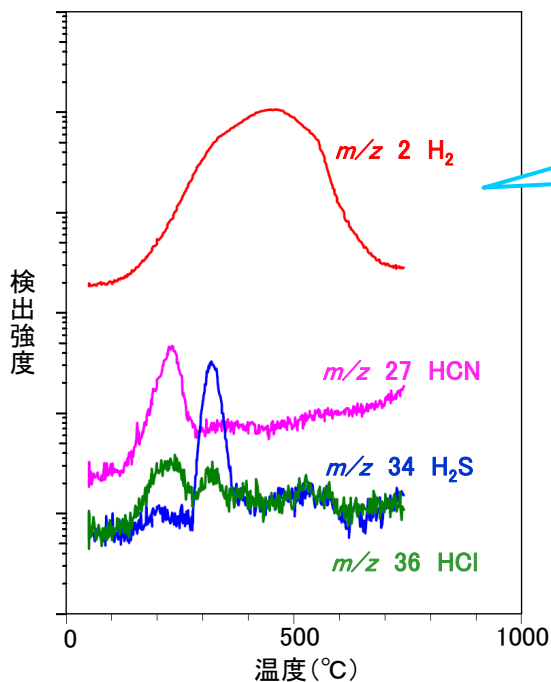
めっき膜にガスが含有されている場合、はがれや膨れ、膜中の気泡など不良の原因となる場合があります。めっき膜に含有されているガスについて調査するには、高真空中で試料を昇温させて脱離したガスを測定できるTDSが有効です。

以下にSUS部材上にNi/Auめっきを施した試料について、TDS分析を行った結果を示します。めっき膜から $H_2$ 、HCN、 $H_2S$ 、HClの脱離が確認できました。また、定量値の算出を行いました。

### データ



不定形試料も分析可能！



めっき膜から  
 $H_2$ 、HCN、 $H_2S$ 、HClが脱離！

$m/z$	換算分子種	分子数(個)
2	$H_2$	3.0E+16
36	HCl	3.5E+13

図2 SUS部材上Ni/AuめっきのTDS分析結果

表1 検出成分の定量値算出結果

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！